

硅基氮化镓外延片厂家 GaN On Si外延厂商

产品名称	硅基氮化镓外延片厂家 GaN On Si外延厂商
公司名称	苏州恒迈瑞材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:恒迈瑞 型号:6英寸 产地:苏州
公司地址	苏州市吴中区苏蠡路60号（蠡盛大厦）507室（注册地址）
联系电话	15366208370

产品详情

硅基氮化镓外延片厂家 GaN On Si外延厂商

苏州恒迈瑞材料科技有限公司生产的硅基氮化镓外延片可用于650V电子电力HEMT及RF射频高电子迁移率晶体管.目前我司硅基氮化镓外延片结构可分为D-MODE耗尽型HMET结构，E-MODE增强型HEMT结构，以及RF HEMT结构，部分结构参数可根据客户设计需求定制。

D/E mode硅基氮化镓外延片

尺寸：2英寸 4英寸 6英寸 8英寸

厚度：675um 1000um 1300um 1500um

外延层总厚度：2-5.5um

RF HEMT硅基氮化镓外延片

尺寸：2英寸 3英寸 4英寸 6英寸

厚度：1000um 1300um 1500um

外延层总厚度：2-3um

硅衬底电阻率：>3000 cm

GaN氮化镓材料之所以能在功率电子器件领域得到广泛的应用，主要是因为GaN材料所拥有的两个重要特性：禁带宽度大（ 3.4eV ），临界击穿场强高（ 3 MV/cm ）。GaN氮化镓材料大的禁带宽度，使得其制备的功率器件可以在没有复杂设计的散热装置的辅助下正常工作，这样可以大幅降低电力电子设备的体积和成本。又因为击穿电场强度与能带的平方成正相关，GaN氮化镓材料的击穿电压理论上可达到大于 3 MV/cm 的水平，远大于Si和GaAs。此外，GaN材料同时还拥有非常卓越电子传输特性，其中包括更高的迁移率，更大的饱和漂移速度。这些使其非常适合用于制作功率电子器件。